

二焦点レンズを用いたシリコンウェーハの厚み測定

Measurement of Silicon Wafer Thickness Using a Double-Focus Lens

上 村 康 幸^{*}·谷 泰 弘^{*}·渡 部 和^{**}·佐 藤 壽 芳^{***} Yasuyuki KAMIMURA, Yasuhiro TANI, Kazushi WATANABE and Hisayoshi SATO

1.緒言

半導体の基板に使用されるシリコンウェーハは,現在8 インチが主流であるが,今後300mmさらには450mmと 大口径化しようとしている¹¹.一方,半導体デバイス製造 においては,小型化・高集積化に伴いパターン形成時の被 写体深度が小さくなり,大口径ウェーハほど高平坦化 (TTV)が要求されている.

ウェーハを平坦化する加工工程に、劣悪な作業環境を抑 え自動化を促進するために、ラッピング工程を研削加工に 置き換える片面の平面研削盤が使用されようとしてい る²³⁾.真空チャックされたウェーハを平面研削盤で研削 加工すると、一般に、加工時の熱変形などによりウェーハ の中心部が多く削れ中凹の形状が得られる.このような形 状を抑制するために、砥石主軸を傾けて補正する研削加工 が採用されている.その際、研削後のウェーハのTTV(厚 みむらであり、ウェーハの裏面を基準としたときの表面の 凹凸)をオンマシンで 0.1 µm 以下の精度で高速に自動測 定したいという要求がある.TTVをオンマシン測定する ことで、高精度の補正研削が可能となり、大口径ウェーハ の高平坦化が達成できる.

8インチ以下のシリコンウェーハのTTV 測定は,操作 が簡単で容易に高分解能が得られる静電容量方式が多用さ れている.しかし,ウェーハを真空チャックした加工機上 で測定する場合,チャック面の溝が影響し正確なTTV が 得られない.2つのセンサを対向させ,両側から位置を測 定する場合,ウェーハをその都度チャック面から取り外し て測定する必要がありオンマシン測定できない.また,両 センサの走査軸の位置ずれが問題となる.そのため現状の 方法は適用できない.

**日立ビアメカニクス(株)

一方,ガラスなどの透明な材料を対象とした厚み測定に は、①レーザ光を被測定物に斜めに入射させその表面と裏 面で反射した二つのビーム間隔から厚みを測定する方法⁴⁾ や②スーパールミネッセントダイオードを光源として被測 定物の表面および裏面からの反射光と参照光ミラーからの 反射光とを交互に合波・干渉させて厚みを測定する方法⁵⁾ がある.しかし、①の方法は、被測定物表面の傾き角に敏 感で,表面のうねり成分の程度によってはその正反射光が 得られなくなる.また、光を特定の角度で入射させるため、 被測定物の表面と裏面で得られる反射光は正確な厚みに対 応しない.さらに、測定誤差が1から2μmと大きいため シリコンウェーハのTTV 測定には適さない.

一方,②の方式は,被測定物を走査する駆動ステージと 参照光ミラーを位相変調させる駆動ステージとを交互に走 査させ,透明なガラスの厚みと屈折率を同時に1Hz前後 で測定できる.しかし,シリコンウェーハのTTV測定で は100Hz以上の測定速度が要求されており,2軸以上の ステージを走査させる方式では限界があり適用は困難であ る.

そこで本研究では、チャック面の溝に影響されず大口径 ウェーハの TTV を高精度にオンマシンで高速測定できる 方法として、シリコンを透過する赤外光を被測定物に垂直 に入射させ、二焦点を持つ対物レンズを適用した厚み測定 法を提案する.

2. シリコンウェーハの厚み測定原理

2.1 厚み測定用光学系

シリコンの厚みを一方向から光学的に測定するために は、使用する光がウェーハを透過する必要がある.シリコ ンを透過する波長域は 1.2-8 μ m の赤外光で、その中でも 1.3-1.5 μ m の赤外光がより強い透過強度が得られると報告 されている⁶. そこで、図1に示した本光学系のレーザダ イオードには、波長 1.3 μ m のものを使用した.

^{*}東京大学生産技術研究所 情報・システム部門

^{***}東京大学名誉教授

レーザダイオードから出た光は基本的にはコリメータレ ンズで平行光にすべきであるが、レーザダイオードをコリ メータレンズの焦点位置に正確にセットできなかったこと や光軸中心に対するコリメータレンズの取付け精度の問題 によりコリメータレンズを使用しない光学系を構成した. レーザダイオードの前に置かれた球レンズから出た光を、 光径 ϕ 0.5 mm, 拡がり角 8.5°の状態で無偏光ビームスプリ ッターに入れ、ビームスプリッター(透過率50%)から 直進する光を対物レンズで集光させた、ウェーハの表面と 裏面からの反射光はビームスプリッターで 90 度に曲げら れ,フォトダイオードで受光される.光の乱反射や球面収 差などの影響を小さくするため、ビームスプリッターと対 物レンズ間の光軸中心に $\phi0.8 \, \text{mm}$ 穴の開いたスリットを 設けた. その状態で、ウェーハの裏面の位置を集光点より 極僅か対物レンズに近くなるようにセットした.そして, ウェーハを光軸に垂直に保ったまま対物レンズから遠ざか る方向に光軸に沿って0.3 mm/sの一定速度で移動させた. するとまず集光点がウェーハの裏面に一致し、このとき反 射光強度は極大値となる. さらにウェーハを遠ざけると. 今度は集光点が表面に一致した点で反射光強度の最大値が 現われ、図1のようにウェーハの裏面と表面で2つのピー クが得られる.このピーク間距離からウェーハの厚みを算 出する.

本光学系の対物レンズには、光通信用レンズの開口数 NA=0.59とNA=0.37の2種類を使用した.透過率は何 れも98%以上である.また、反射光を受光するフォトダ イオードには、赤外受光領域1.0~1.6 µmのものを採用し た.被測定物の単結晶シリコンウェーハには、厚みが① 0.664 mm、② 0.623 mm、③ 0.502 mmの3種類を用いた. 厚みは何れもマイクロメータで測定した.また、ウェーハ ①、②の屈折率は、共に3.4981で赤外分光計により測定 した値である.一方③のウェーハの屈折率は、両面が鏡面 であったため、赤外分光計では裏面の粗さによる反射光が 影響し測定不能であった.



2.2 厚み測定の理論式

図2に合焦点を利用した厚み測定の概略図を示す.角度 θ,で集光した光がウェーハの中に入ると、入射光は屈折 し、角度 *θ*。で等光する状態に変化する. そのため、太線 で示された表面に合焦点の状態から Y だけウェーハをレ ンズに近づけたときに、細線で示される裏面に合焦点の状 態となる. したがって, 厚みtと移動量 Yの関係は, (1) 式のように表わすことができる.一方,スネルの屈折式は (2) 式で示される. ここで, n は空気の屈折率で1とし た. n_2 はシリコンウェーハの屈折率, θ_i は集光角, θ_c は屈 折により変化した集光角である.(2)式の関係を用いて 式のθ を消去すれば(3)式のような厚みtの理論式 を導き出せる.このように厚みtは表面と裏面で合焦点を 作るための移動量 Yと集光角 θ_i, そしてウェーハの屈折 率 n_oの関数となる. すなわち, ウェーハの屈折率 n_oと集 光角θ,を既知の値とすれば、Yを実測することで、厚みt を算出できる.ここで移動量Yの値は,使用する対物レ ンズの開口数 $(NA = n_1 \sin \theta_i)$ すなわち光の集光角により 変化する.





図3に、NA = 0.59(θ_i = 36.629°)の対物レンズを使用 したときの各ウェーハの厚みに対応する反射光強度のピー ク間距離を示す.厚みが増すにつれて、減衰のため裏面に 合焦した点の反射光強度は小さくなる傾向を示し、(3)式 の通りピーク間距離 Y の計測値はその厚みに対応して大 きくなることが分かる.

2.3 集光角の算出方法

図1に示した本光学系の幾何学的配置等から対物レンズ の集光角を正確に計算することは、レンズの取付け精度等 の問題により困難である.そこで、(3)式に示した厚み測 定式を(4)式のような集光角の式に変形し、屈折率n₂と 厚みtを既知として、厚みに対応するピーク間距離を実測 すれば、レンズの取付け精度が悪くてもそれに影響されず 正確な集光角 θ_iを算出することが可能となる. 研

究



図3 各ウェーハの厚みに対応したピーク間距離

$$\theta_i = \sin^{-1} \sqrt{\frac{Y^2 n_2^2 - t^2}{Y^2 - t^2}}$$
(4)

図3に示したウェーハ①を基準にして(4)式から集光 角を算出すると $\theta_1 = 23.357^\circ$ の値が得られた.この値は, 厚みt = 0.664 mm (マイクロメータ値)と屈折率 $n_2 =$ 3.4981(赤外分光計値)を既知とし,厚みに対応するピー ク間距離Y(Y = 0.1754 mm)を計測して算出した.幾何 学的配置等から計算した集光角と(4)式から算出した値 とを比較すると13°前後の大きな差が見られた.このずれ について言及すれば,光軸に対する対物レンズの取付け精 度が影響し,光学系の幾何学的配置等から計算した集光角 に差が生じたものと考えられる.この算出した集光角を基 に厚みを算出した結果,①=0.664 mm,②=0.623 mm, ③=0.501 mmの値が得られ,マイクロメータ値に全ての ウェーハの厚みが一致した.

2.4 ウェーハの屈折率の算出方法

ウェーハの屈折率は,酸素や炭素その他の元素の不純物 によって変化する可能性がある.集光角の異なるシステム での厚みが算出されれば,ウェーハ毎に変化すると思われ る屈折率を算出することができる.屈折率の算出方法とし て,二焦点レンズを使用した方法を以下に提案する.

図1で示した対物レンズを二焦点レンズに置き換えれ 離を減らすことができる.ウェーハの実移動距離を減らせ

衣1 屈折率の昇出値と亦外分元訂による測定値との比

			Incider	nt angle	
	Refractive indexCalculationmeasured byresult of	Calculation	θ1=23.357°	<i>θ</i> ₂ =19.201°	
		Distance between the			
	an infrared ray	ray refractive ter index n ₂	peaks		
	spectrometer		Y ₁ mm	Y₂ mm	
1	3.4981	3.4976	0.1754	0.1801	
2	3.4981	3.4976	0.1645	0.1689	
3		3.4963	0.1323	0.1359	

ば、二焦点レンズの集光角 $\theta_1 \ge \theta_2$ で(3)式と同様な式 を2つ得ることができる.そこで(5)式のようにその両 者の比をとれば、未知の厚みtが消去され、(6)式のよう に屈折率 n_2 の式を導き出すことができる.この式は、2.3 節の方法で求められる二焦点レンズの集光角 $\theta_1 \ge \theta_2$ そし て二焦点レンズで測定されるピーク間距離の比をとること でウェーハの屈折率を算出できることを示している.

表1に,①,②,③のウェーハの屈折率を(6)式から 算出した値と赤外分光計で測定された値とを比較した結果 を示す.屈折率 n_2 の値は,二焦点レンズの各集光角を(4) 式より計算された $\theta_1 = 23.357^\circ$, $\theta_2 = 19.201^\circ$ とし,二焦 点レンズを用いて測定されるピーク間距離 Y_1 , Y_2 の値を (6)式に代入して算出した.算出した屈折率 n_2 は表1の ように赤外分光計値に近い結果が得られた.また,③のウ ェーハのように屈折率が未知のウェーハでも,(6)式から 算出できることが分かった.

$$n_{2} = \sqrt{\frac{(1 - \sin^{2}\theta_{2})\sin^{2}\theta_{1} - (1 - \sin^{2}\theta_{1})\sin^{2}\theta_{2}(\frac{Y_{2}}{Y_{1}})^{2}}{1 - \sin^{2}\theta_{2} - (1 - \sin^{2}\theta_{1})(\frac{Y_{2}}{Y_{1}})^{2}}} \cdots (6)}$$

3. 二焦点レンズの焦点間距離を利用した厚み測定

単レンズによる厚み測定では、ウェーハの厚みに相当す る分(約 t/n_2)だけウェーハを移動させる必要がある. ところが、厚み測定に二焦点レンズを使用すれば、二焦点 レンズの焦点間距離($f_2 - f_1$)によりウェーハの実移動距 離を減らすことができる.ウェーハの実移動距離を減らせ

24

	研	究	速	報
--	---	---	---	---

れば測定時間が短縮でき,被測定物の移動する場合には測 定点のずれを最小化でき、高精度な厚み測定を実現でき る.

そこで、 $f_1 = 0.358 \text{ mm} \ge f_2 = 0.753 \text{ mm}$ の二焦点レンズ を使用して、厚み測定を試みた.図4に、二焦点レンズの 焦点間距離を利用してピーク間距離 Y2-1を測定した結果を 示す.測定したシリコンウェーハは,厚みt=0.664mm (マイクロメータ値)のものを採用した. 図中の太線は f₁ の焦点距離をもつレンズによる反射光強度を、細線はf, の焦点距離をもつレンズによる反射光強度を測定した結果 である.ピーク間距離 Y2-1の測定値は、二焦点レンズの f1 およびf,のレンズで得られる反射光強度の測定位置を, 図4に示した静電容量センサで検知し同定した.図4の結 果で,f,レンズによる表面のピークとf,レンズによる表面 のピーク間距離が二焦点レンズの焦点間距離 $(f_2 - f_1)$ を 示している.また,f,レンズによる表面の反射光とf,レン ズによる裏面の反射光のピーク間距離が二焦点レンズのピ ーク間距離 Y2-1 を示している.二焦点レンズによる厚み測 定の理論式は、二焦点間距離と二焦点レンズによるピーク 間距離との和あるいは差に屈折率の項を掛けることで、(7) 式のように定義できる. ピーク間距離 Y21 にかかる符号 は、f₁レンズで得られる表面のピークよりf₂レンズで得ら れる裏面のピークが後に検出される場合を負、先に検出さ れる場合は正となる.

ここで、 $f_2 - f_1$ (二焦点間距離)は,	図4から実測した
--------------------------	-----	----------



Thickness=0.664mm

値 0.3604 mm を採用した. また, ピーク間距離 Y₂₋₁は 0.1802 mm と実測した.二焦点レンズのそれぞれの集光角 と屈折率は、2.4節に示した $\theta_1 = 23.357^\circ$ 、 $\theta_2 = 19.201^\circ$ お よび n₂ = 3.4976 と同値である.これらの値を(7)式に代 入し厚みを算出すると、t = 0.6644 mm となりマイクロメ ータ値に一致した.これにより.二焦点間距離でウェーハ の厚みを単レンズと同じように算出できることが分かっ た、しかし、今回使用した焦点間距離ではウェーハの実移 動距離を減少させられる結果は得られなかったが、二焦点 レンズの焦点間距離をうまく設定すれば、実移動距離を測 定精度に有効な桁数だけに限定でき,高精度な厚み測定が 可能となる.

4. 結 言

本研究では、チャック面の溝に影響されず大口径ウェー ハのTTVを高精度にオンマシン測定できる方法として、 二焦点レンズとシリコンを透過する赤外光を使用し、次の ような方法を提案した.

- 1) 光学系のシステムを構成する際に、既知の屈折率と厚 みをもつ標準試験片で厚みに対応するピーク間距離を 実測して、対物レンズの集光角を同定する.
- 2) 上記したシステムを用い、二焦点レンズを使用して、 未知の屈折率を算出する.
- 3) 同定した集光角と算出した屈折率そしてウェーハの厚 みに対応した移動距離から厚みを算出する.

また、二焦点レンズを用いた方法では、レンズあるいは 試料の実移動距離を少なくでき. 厚み測定の高精度化の可 能性を示した.

(2002年2月26日受理)

文 献

- 高須新一郎、シリコンウェーハはどこまでおおきくなるか、 1) 応用物理, 65-8 (1996), 832-840.
- 2) 安部孝夫,大口径ウェーハのための次世代加工技術,電子 材料, 35-7 (1996), 22-28.
- 3) 阿部耕三・ほか4名, ぜい性材料の超精密研削技術の研 究 — 超精密研削装置の試作 — , 精密工学会誌, 59-12 (1993), 1985-1990.
- 釜田富士夫, アンリッテクニカル, 45号, (1983), 30-34. 4)
- 田尻秀幸・ほか4名,低コヒーレンス光干渉による屈折率 5) と厚さ同時精密測定,信学技報,OPE 96-116,12 (1996), 37 - 42.
- 小林昭・ほか2名,非金属材料の工学的性質,(1964), 6) 195, 東京, 地人書館.

図4 二焦点レンズの焦点間距離を利用したピーク間距離の測定

25